13

Полевая электронная эмиссия композитных катодов с наноструктурной поверхностью

© С.М. Лупехин

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 191186 Санкт-Петербург, Россия e-mail: sml50@mail.ru

(Поступило в Редакцию 4 декабря 2014 г.)

Проведены экспериментальные исследования полевой электронной эмиссии композитных медноуглеродных (Cu-C) катодов с наноструктурной поверхностью. Эмиссионная поверхность катодов формировалась методом высоковольтного вакуумного разряда. Изучены морфология и элементный состав эмиссионной поверхности. Вольт-амперные характеристики катодов исследованы при рабочих напряжениях 1.8-5.6 kV и зазорах анод-катод 0.5 mm. Установлено, что в условиях технического вакуума при указанных напряжениях эмиссионный ток Cu-C-катода составлял 5-270 µA.

Введение

Исследования полевой электронной эмиссии катодов с эмиссионной поверхностью, созданной на основе наноструктурированного углерода, вызывает неизменный интерес. Это прежде всего связано с возможностью создания полевых электронных эмиттеров с высокой стабильностью и воспроизводимостью эмиссионных характеристик в условиях технического вакуума.

К настоящему времени полевые эмиссионные свойства наноструктурных углеродных пленок и композитных пленок на основе углерода недостаточно изучены. Тем не менее существует достаточно большое количество экспериментальных [1–5] и теоретических [6,7] работ, указывающих на хорошую перспективу создания высокоэффективных катодов на основе наноструктурной углеродной поверхности.

В настоящей работе проведены экспериментальные исследования эмиссионных характеристик полевых планарных композитных Cu–C-катодов с наноструктурной эмиссионной поверхностью, работающих в условиях технического вакуума. Изучена морфология и проведен рентгеноспектральный анализ элементного состава эмиссионной поверхности.

Методика эксперимента

Эмиссионные свойства композитного медно-углеродного катода экспериментально исследовались на специально созданных образцах планарных катодов с наноструктурной эмиссионной поверхностью. Рабочее тело катода изготавливалось из вакуумно чистой меди в виде плоского диска диаметром $d_k = 4 \text{ mm}$ и толщиной h = 1 mm с цилиндрической контактной ножкой держателем. Катод устанавливался в вакуумной диодной системе на металлическом вакуумно-изолированном высоковольтном вводе.

Исследования эмиссионных процессов проводились в диоде с плоским круглым анодом из меди диаметром

 $d_a = 30$ mm. Диод конструктивно располагался в металлостеклянной вакуумной камере, имеющей систему динамической безмасляной вакуумной откачки до давлений $P \sim 10^{-4} - 10^{-5}$ Pa. Расстояние между плоским катодом и плоским анодом составляло $D_{ka} = 0.5$ mm.

Электронный ток с катода I_k и рабочее напряжение диода U_{ak} регистрировались цифровым 2-канальным самописцем ACK-3102. Схема подключения регистрирующей системы к диоду приведена на рис. 1.

Для изучения геометрии электронного пучка, сформированного в процессе полевой электронной эмиссии (ПЭЭ), использовалась диодная система с анодом в виде проводящего люминесцентного экрана. Расстояние катод — анод $D_{ka} = 0.5$ mm. Цифровое изображение отпечатка электронного пучка на люминесцентном экране, представленное на рис. 2, регистрировалось цифровой видеокамерой с сохранением видеофайла на ПК.



Рис. 1. Схема измерительной установки: D — вакуумный диод, C — катод, A — анод, R — ограничительное сопротивление, μA — микроамперметр, V — вольтметр, PS — источник питания, ACK-3102 — цифровой самописец, PC — персональный компьютер.



Рис. 2. Цифровое изображение отпечатка электронного пучка при различных рабочих напряжениях.

Для формирования наноструктурной эмиссионной поверхности катода использовался оригинальный метод модифицирования поверхности твердого тела [8,9]. В основе метода лежит воздействие плазмы импульсного высоковольтного вакуумного разряда, ионного пучка из плазмы и электронного пучка на твердотельную мишень. Морфология сформированной эмиссионной поверхности и элементный состав исследовались в растровом электронном микроскопе (РЭМ) CarlZeiss серии EVO MA/LS с встроенным рентгеновским спектрометром. Наноморфология эмиссионной поверхности исследовалась с помощью сканирующего атомно-силового микроскопа (ACM) марки NTMDT-4Р.

Результаты эксперимента

В процессе экспериментальных исследований зарегистрирована ПЭЭ планарных медно-углеродных катодов при рабочих напряжениях $U_{ak} = 1.8-5.6$ kV. Катод работал в условиях технического вакуума в интервале давлений $P \sim 10^{-4}-10^{-5}$ Ра. Проведены исследования эмиссионных характеристик катодов с диаметром плоской эмиссионной поверхности $d_k = 4$ mm и расстоянием анод–катод $D_{ak} = 0.5$ mm.

Типичная вольт-амперная характеристика (ВАХ) катода приведена на рис. 3. Минимальный устойчивый ток с катода $I_{k \min} = 5.0 \,\mu$ А зарегистрирован при рабочем напряжении $U_{ak} = 1.8 \,\text{kV}$. Максимальное значение тока $I_{k \max} \approx 270 \,\mu$ А достигнуто при $U_{ak} = 5.6 \,\text{kV}$. В процессе работы катода среднее значение напряженности электрического поля у эмиссионной поверхности плоского катода в начале устойчивой полевой эмиссии составляло $E = 3.6 \cdot 10^4 \,\text{V/cm}$. Полученные зависимости $I_k = f(U_{ak})$ не подчиняются закону Фаулера–Нордгейма.

Изображения электронного пучка, приведенные на рис. 2, зарегистрированы при различных рабочих на-

пряжениях U_{ak} в интервале 1.8-3.2 kV. По мере увеличения U_{ak} линейные размеры сечения пучка увеличиваются, при этом вокруг основного пятна появляется диффузное свечение. Структура пятна не изменяется и представляет собой сплошное однородное пятно.

В результате исследований морфологии и элементного состава эмиссионной поверхности получены данные о характере ее наноструктурного рельефа и особенностях элементного состава.

На рис. 4 приведено характерное изображение поверхности, полученное в РЭМ. Микрорельеф поверхности



Рис. 3. Вольт-амперная характеристика планарного полевого CuC-катода.



Рис. 4. Характерные изображения эмиссионной поверхности CuC-катода, полученные в РЭМ.



Рис. 5. Изображение нанорельефа эмиссионной поверхности CuC, полученные на ACM: *а* — изображение фрагмента с кратерной структурой; *b* — изображение фрагмента кластерной наноструктуры.

имеет характерные впадины (кратеры), равномерно расположенные по всей поверхности. Относительная доля площади поверхности, которую занимают кратеры, составляет 25–30%. Рентгеноспектральный анализ поверхностного слоя толщиной $h \approx 100$ nm показал наличие на поверхности композитного слоя, сформированного из меди и углерода. Процентный состав атомов меди в области кратеров 20–30%, атомов углерода 70–80%. На поверхности вне кратеров содержание атомов углерода $\approx 90\%$, атомов меди $\approx 10\%$.

Исследование нанорельефа поверхности в АСМ показало, что вся рабочая поверхность катода, включая кратеры, покрыта характерными плотно упакованными нанокластерными образованиями (рис. 5). Линейные размеры кластеров $L_k = 100-200$ nm. Средняя глубина рельефа поверхности вне кратеров $H \approx 100$ nm. Средняя глубина кратера $H_k \approx 500-800$ nm.

Обсуждение результатов

Исследование эмиссионных свойств рабочей поверхности катода в виде тонкой медно-углеродной пленки, созданной методом высоковольтного вакуумного разряда, привело к следующим важным результатам.

Полученный композитный материал обладает достаточно высокой эмиссионной способностью при низких значениях рабочего напряжения $U_{ak} = 1.8-5.6$ kV. При этом напряженность электрического поля составляет ~ 10^4 V/cm. Катод устойчиво работает в условиях технического вакуума при $P \sim 10^{-4}-10^{-5}$ Pa.

Исследование нано- и микрорельефа эмиссионной поверхности показало, что геометрия существующего микрорельефа рабочей поверхности не приводит к усилению напряженности электрического поля до автоэмиссионных значений $E \sim 10^6 - 10^7$ V/cm за счет геометрического фактора. Следовательно, механизм полевой электронной эмиссии нельзя рассматривать как классический автоэмиссионный, подчиняющийся закону Фаулера–Нордгейма. Этот факт подтверждается нелинейным характером зависимости $I_k = f(U_{ak})$ в координатах Фаулера–Нордгейма в указанном интервале рабочих напряжений.

Механизм формирования эмиссионного процесса для подобных углеродных наноструктур рассмотрен в работах [6,7]. На качественном уровне представленная модель достаточно корректно объясняет полученные в настоящей работе результаты. Наиболее вероятно, что основную роль в эмиссионном процессе играет углеродная наноструктура. Медь в составе материала эмиссионной поверхности может существенно влиять на стабилизацию эмиссии, поскольку имеет высокую электро- и теплопроводность. Это косвенно подтверждается стабильной работой катода в течение десятков часов.

Структура полученного отпечатка электронного пучка указывает на то, что на рабочей поверхности катода формируется сплошная область ПЭЭ с четко обозначенной границей. При этом площадь эмиссионного источника расширяется с увеличением рабочего напряжения (рис. 2). Изучение данных по наноструктуре эмиссионной поверхности совместно с зарегистрированным изображением электронного пучка привело к предположению, что в процессе эмиссии работает область катода с плотно упакованными эмиссионными центрами. Формирование центров, вероятно, связано с кластерной наноструктурой эмиссионной поверхности.

Заключение

Экспериментальное исследование ПЭЭ планарных медно-углеродных катодов, рабочая поверхность которых сформирована методом высоковольтного вакуумного разряда, привело к следующим результатам.

Созданные катоды устойчиво работают при давлении остаточных газов $\sim 10^{-4} - 10^{-5}$ Ра и рабочих напряжениях $\sim 10^3$ V. Значение эмиссионного тока составляет $\sim 10^{-6} - 10^{-4}$ А.

На рабочей поверхности катода формируется сплошная область полевой эмиссии, связанная, очевидно, с работой плотно упакованных эмиссионных центров.

Таким образом, использование оригинальной методики формирования эмиссионной поверхности полевых планарных Cu–C-катодов привело к созданию эффективных электронных источников, стабильно работающих в условиях технического вакуума при низких рабочих напряжениях. При этом напряженность электрического поля составляет ~ 10⁴ V/cm.

Список литературы

- Бобков А.Ф., Давыдов Е.В., Зайцев С.В. и др. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 6. С. 367–371.
- [2] Суздальцев С.Ю., Яфаров Р.К. // ФТТ. 2004. Т. 46. Вып. 2. С. 367–371.
- [3] Белянин А.Ф., Самойлович М.И. и др. // Нано- и микросистемная техника. 2005. № 8. С. 39–48.
- [4] Ляшенко С.А., Волков А.П., Образцов А.Н. // ЖТФ. 2012.
 Т. 82. Вып. 2. С. 94–98.
- [5] Рахимов // УФН. 2000. Т. 170. № 9. С. 996–998.
- [6] Образцов А.Н., Волков А.П., Павловский И.Ю. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1999. Т. 69. Вып. 5. С. 381–386.
- [7] Образцов А.Н., Волков А.П., Павловский И.Ю. // Письма в ЖЭТФ. 1998. Т. 68. Вып. 1. С. 56–60.
- [8] Лупехин С.М. // Патент № 121813. 30.03.2012 г.
- [9] Лупехин С.М., Ибрагимов А.А, // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 6. С. 134–138.